



Układy 4096-bitowych pamięci statycznych ROM mają następujące cechy:

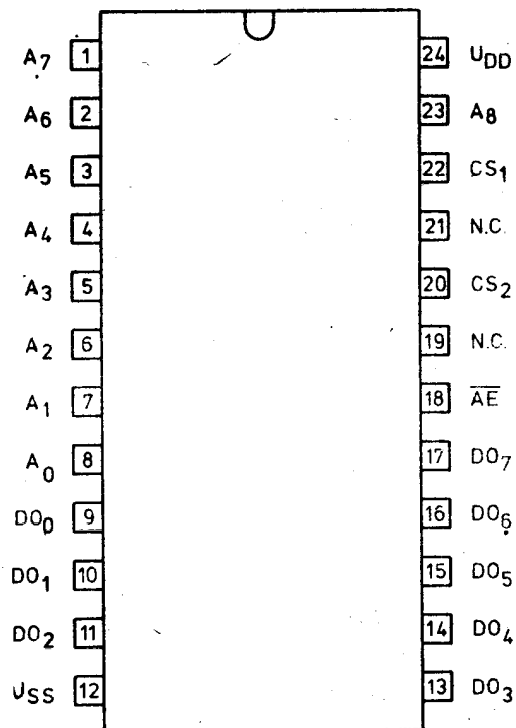
- trójstanowe wyjścia danych,
- możliwość pełnej współpracy z układami TTL,
- dwa wejścia wyboru układu CS_1 , CS_2 pozwalające na współpracę do 4 pamięci w jednym systemie,
- wejście zezwolenia odczytu adresu umożliwia pracę synchroniczną.

W wersjach standardowych i na zamówienie zawartość matrycy pamięci i kod sygnałów CS_1 i CS_2 programowane są maską przez producenta i oznaczane dwuliterowym kodem /w miejscu liter XX/

MCY 7304NXX
Pamięć statyczna ROM
8 x 512 bitów

LSI NMOS
Bramka krzemowa

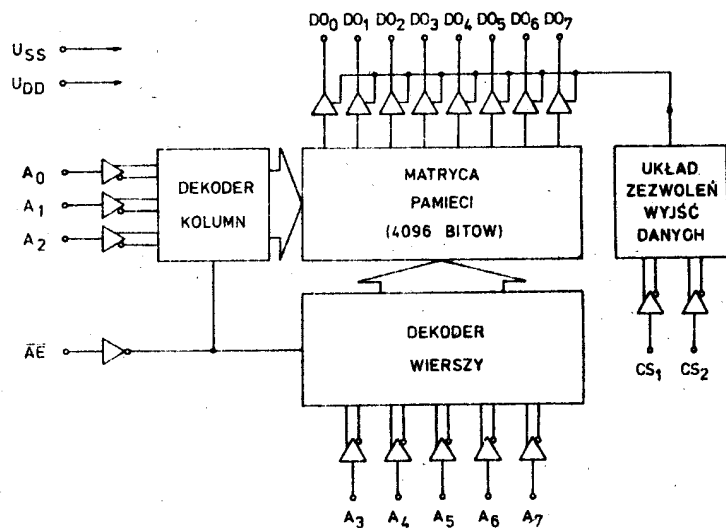
Obudowa CE 73



Układ wyprowadzeń

Opis wyprowadzeń

- U_{SS} , U_{DD} - wejścia zasilające
 $A_0 \div A_8$ - wejścia adresowe
 CS_1 , CS_2 - wejścia wyboru układu
 \overline{AE} - wejście zezwolenia odczytu adresu
 $DO_0 \div DO_7$ - wyjścia danych
 N.C. - wyprowadzenia niewykorzystane



Blokowy schemat wewnętrzny

Parametry dopuszczalne

$/U_{SS} = 0 \text{ V}/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
U_{DD}	Napięcie zasilania	V	-0,5	7
U_W	Napięcie na pozostałych wyprowadzeniach	V	-0,5	7
P_D	Moc rozpraszana	W		1
t_{amb}	Temperatura otoczenia w czasie pracy	$^{\circ}\text{C}$	0	+70
t_{stg}	Temperatura przechowywania	$^{\circ}\text{C}$	-40	+125

Parametry charakterystyczne statyczne

$/U_{SS} = 0 \text{ V}, t_{amb} = +25^{\circ}\text{C}/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość		Warunki pomiaru
			min	max	
U_{DD}	Napięcie zasilania	V	4,75	5,25	
U_{IH}	Napięcie wejściowe w stanie wysokim	V	2		
U_{IL}	Napięcie wejściowe w stanie niskim	V		0,8	
I_{II}	Prąd upływności wejść	μA		10	$U_I = 0 - 5,25 \text{ V}$ wejścia razem
U_{OH}	Napięcie wyjściowe w stanie wysokim	V	2,4		$I_{OH} = -200 \mu\text{A}$
U_{OL}	Napięcie wyjściowe w stanie niskim	V		0,4	$I_{OL} = 2,4 \text{ mA}$
I_{DD}	Prąd zasilania	mA		50	$U_I = U_{DD} = 5,25 \text{ V}$ wyjścia otwarte

Parametry charakterystyczne pojemności / $U_{SS} = 0\text{ V}$; $t_{amb} = +25^{\circ}\text{C}$ /

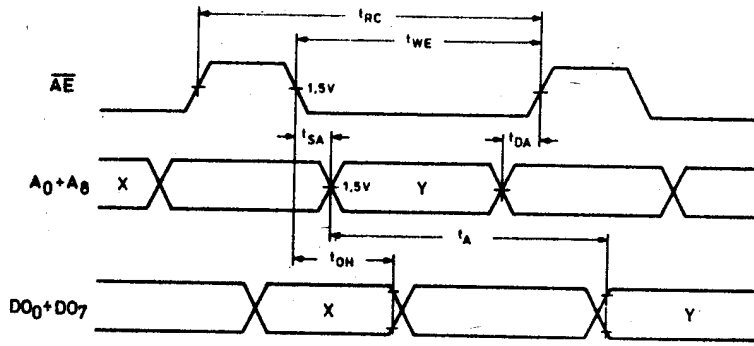
Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	Warunki pomiaru
			max	
C_I	Pojemność wejściowa	pF	6	f = 1 MHz
C_O	Pojemność wyjściowa	pF	10	

Parametry charakterystyczne dynamiczne

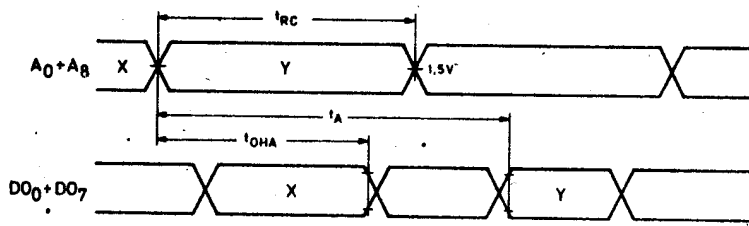
/obciążenie: 1,5 bramki TTL i pojemność 100 pF/

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
Praca synchroniczna				
t_{RC}	Czas cyklu odczytu	ns	700	
t_A	Czas dostępu względem adresu	ns		500
t_{WE}	Czas trwania impulsu zezwolenia odczytu adresu	ns	500	
t_{SA}	Czas ustalenia adresu	ns	0	50
t_{DA}	Czas zanikania adresu	ns		20
t_{OH}	Czas przetrzymywania danych na wyjściach po zezwoleniu odczytu adresu	ns	20	
Praca asynchroniczna				
t_{RC}	Czas cyklu odczytu	ns	500	
t_A	Czas dostępu względem adresu	ns		500
t_{OHA}	Czas przetrzymywania danych na wyjściach po zmianie adresu	ns	20	
Praca synchroniczna i asynchroniczna				
t_{CO}	Czas dostępu względem zezwolenia wyjścia danych	ns		300
t_{OTD}	Czas opóźnienia stanu nieaktywnego wyjść względem zakazu wyjścia danych	ns		300

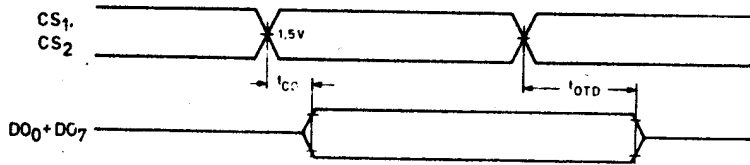
Definicje parametrów dynamicznych



PRACA SYNCHRONICZNA



PRACA ASYNCHRONICZNA



PRACA SYNCHRONICZNA I ASYNCHRONICZNA

Układ MCY 7304NXX jest wykonywany w czterech wersjach /MCY 7304NAA, MCY 7304NAB, MCY 7304NAC, MCY 7304NAD/ odpowiadających generatorom znaków alfanumerycznych.

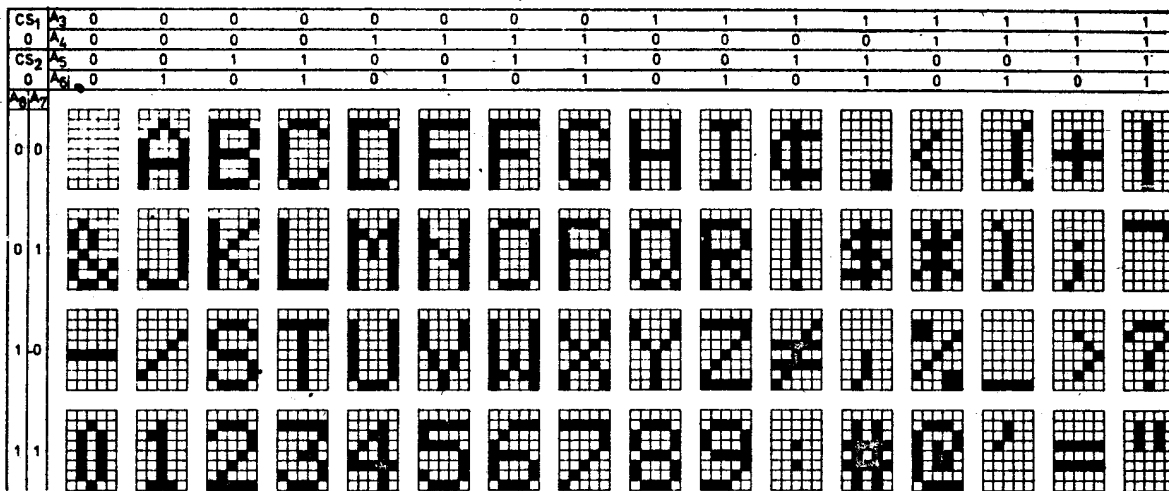
Znaki rozmieszczone są w matrycy 5x7 w układzie odczytu poziomego /wyprowadzenie wiersza, typowe zastosowanie – monitory ekranowe/.

Sześć linii adresowych /A3 ÷ A0/ określa kod znaku, trzy najniższe /A0 + A2/ numer wyświetlanego wiersza.

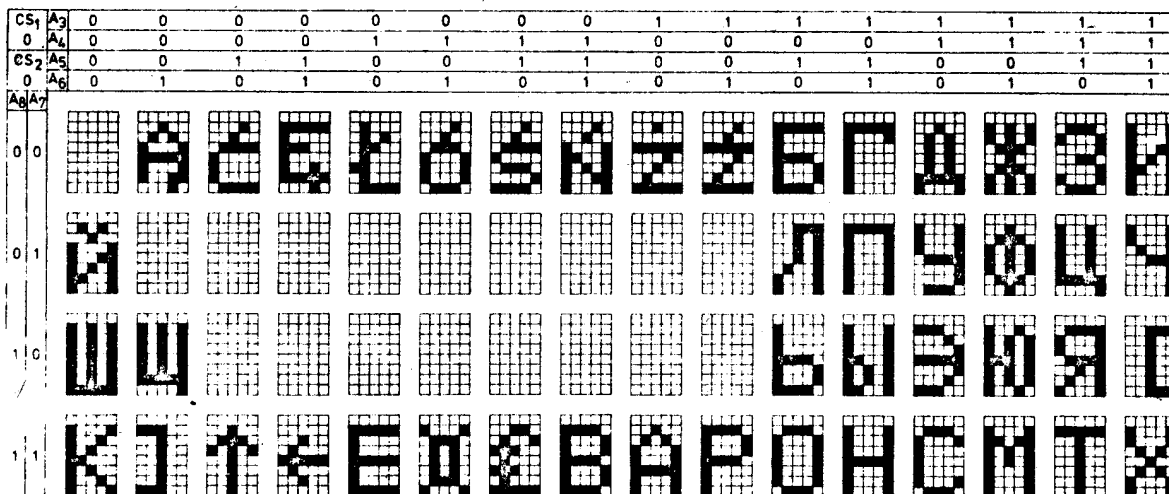
A ₂	A ₁	A ₀	DO ₄	DO ₃	DO ₂	DO ₁	DO ₀
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Rysunek przedstawiający zawartość pamięci MCY 7304NAA

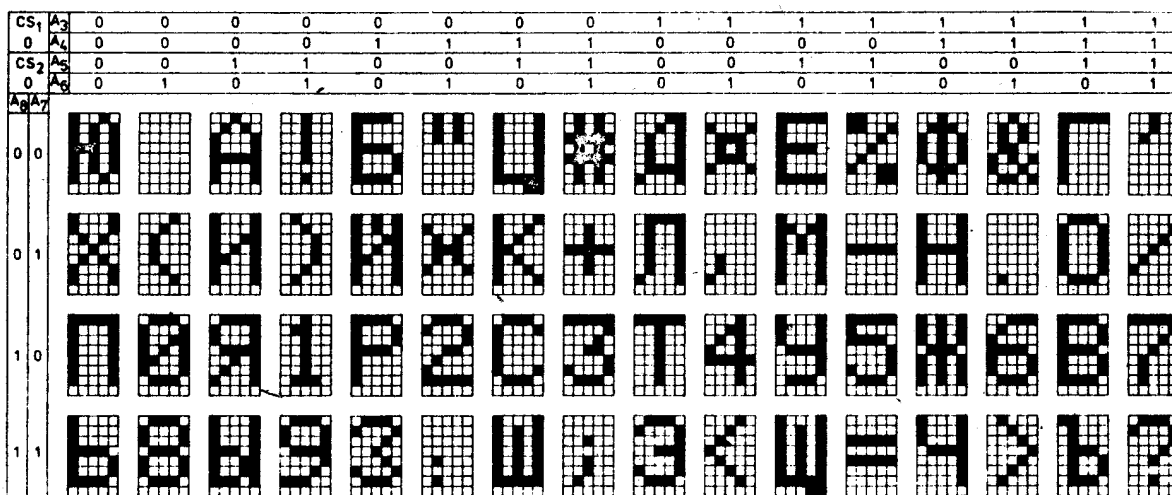
CS ₁	A ₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	A ₂	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
CS ₂	A ₃	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	A ₂	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rysunek przedstawiający zawartość pamięci MCY 7304NAB



Rysunek przedstawiający zawartość pamięci MCY 7304NAC



Rysunek przedstawiający zawartość pamięci MCY 7304NAD